

委員各位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体  
光・電子デバイス第 162 委員会  
委員長 吉川 明彦

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会  
第 76 回委員会・第 80 回研究会 開催案内

日時：平成 24 年 7 月 6 日（金）

委員会：12：00 - 13：00

研究会：13：00 - 17：30

場所：名城大学 名駅サテライト 多目的室

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-26-8 名古屋駅前桜通ビル13階

電話番号：052-551-1666 FAX番号：052-551-1660

<http://www.meijo-u.ac.jp/campus/shisetsu/sate.html>

**委員会**

議題：

- (1) 前回第 75 回委員会議事録承認について
- (2) 委員の異動について
- (3) 次回第 81 回研究会以降の研究会について
- (4) ワイドギャップ半導体スクールについて
- (5) ISPlasma の協賛について
- (6) その他

**研究会** 主 題：「ワイドギャップ半導体パワーデバイス」

委員長挨拶・企画の趣旨説明（13:00 ～ 13:10）

①ワイドギャップ半導体パワーデバイスの現状と展望（13:10 ～ 13:50）

上野 勝典（次世代パワーデバイス技術研究組合）

②超高耐圧SiCバイポーラデバイスに向けた材料およびデバイス研究（13:50 ～ 14:30）

木本 恒暢、須田 淳（京都大学）

③SiC SBDおよびパワーMOSFET開発とインバータ応用（14:30 ～ 15:10）

今泉 昌之（三菱電機）

休憩（15:10 ～ 15:30）

④高速スイッチングGaN-HEMT技術（15:30 ～ 16:10）

藤原 徹也（ローム）

⑤GaN-HEMT技術の現状と電力応用への展開（16:10 ～ 16:50）

吉川 俊英（富士通研）

⑥パワーデバイスの将来とその役割：「Si×WBG」から「Si+WBG」へ（16:50 ～ 17:30）

大村 一郎（九州工大）

---

<追記>

1. 委員会では昼食を用意いたします。
2. 弁当準備の都合等があるため、委員会・研究会の出欠を 6 月 27 日（水）までに日本学術振興会研究事業課 檜崎 様（[jigyouka09@jsps.go.jp](mailto:jigyouka09@jsps.go.jp)）まで、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。